

今では人類の財産となっている超光感度半導体受光素子を太陽電池に使う事に挑戦します。

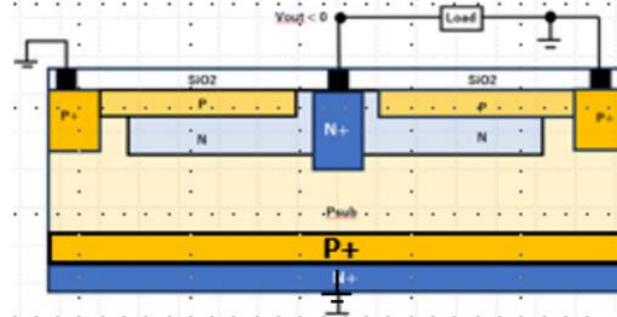
# 募金活動のご案内：責任者 萩原良昭 080-2062-5657

1975年にSONY(萩原)が発明開発したイメージセンサー技術を基礎にしており、製造方法は非常に単純で安価に生産できます。



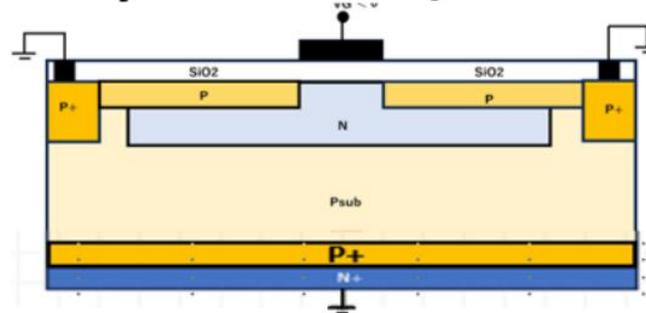
## Pinned Photodiode type Solar Cell (JPA2020-131313)

[Japanese Patent Application JPA2020-131313](#)



- Gate Oxide thickness 0.13  $\mu\text{m}$
- Surface P region  $1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$
- Buried N region  $4.26 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$
- P substrate region  $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
- Backside N+ region  $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-2}$

## Sony SSDM1977/1978 Photo Sensor Device



- Gate Oxide thickness 0.13  $\mu\text{m}$
- Surface P region  $2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$
- Buried N region  $1.7 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$
- P substrate region  $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
- Backside N+ region  $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-2}$

[Hagiwara SSDM1978 Paper on Pinned Buried Photodiode.pdf](#)

**Help!! この新型ダブル接合型太陽電池の原理試作のために開発資金が必要です。**

**応援募金** の額はいくらからでも結構です。下記口座に入金をお願い申し上げます♡

三菱UFJ銀行 厚木支店 店番707 口座番号 0456308 名義者 萩原良昭 (ハギワラヨシアキ)